

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Dezember 2003 (24.12.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/107450 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 51/20,**
51/40

Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/01899

(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
6. Juni 2003 (06.06.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 26 370.1 13. Juni 2002 (13.06.2002) DE

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT** [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

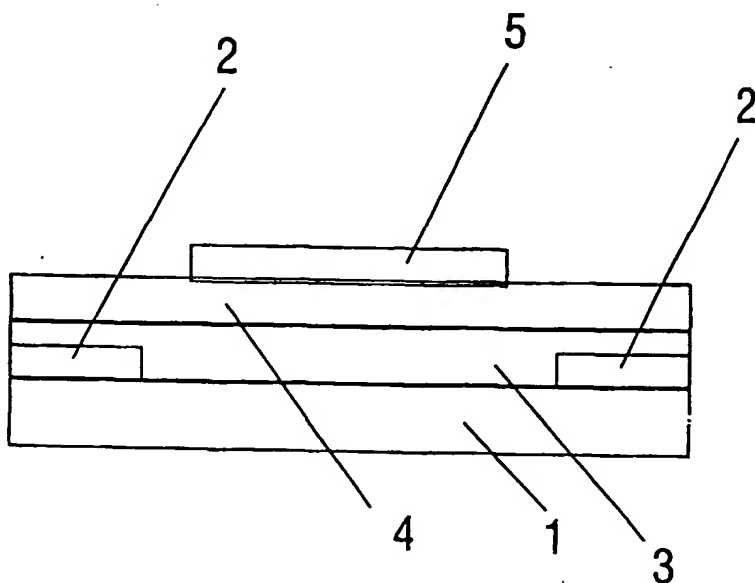
Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **CLEMENS, Wolfgang** [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). **ROST,**

(54) Title: SUBSTRATE FOR AN ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTOR, USE OF SAID SUBSTRATE, METHOD FOR INCREASING THE CHARGE CARRIER MOBILITY, AND ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTOR (OFET)

(54) Bezeichnung: SUBSTRAT FÜR EINEN ORGANISCHEN FELD-EFFEKT TRANSISTOR, VERWENDUNG DES SUBSTRATES, VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER LADUNGSTRÄGERMOBILITÄT UND ORGANISCHER FELD-EFFEKT TRANSISTOR (OFET)



(57) Abstract: The invention relates to a substrate for an organic field effect transistor, a use of said substrate, a method for increasing the charge carrier mobility, and an organic field effect transistor on which an organic functional material can be deposited in an ordered form by using an ordered plastic film as a base for the layer.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Substrat für einen organischen Feld-Effekt-Transistor, eine Verwendung des Substrates, ein Verfahren zur Erhöhung der Ladungsträgermobilität und einen organischen Feld-Effekt Transistor auf dem ein organisches Funktionsmaterial in geordneter Form abgeschieden werden kann. Dies wird dadurch erreicht, dass als Untergrund für die Schicht eine geordnete Kunststoffolie eingesetzt wird.

WO 03/107450 A1